

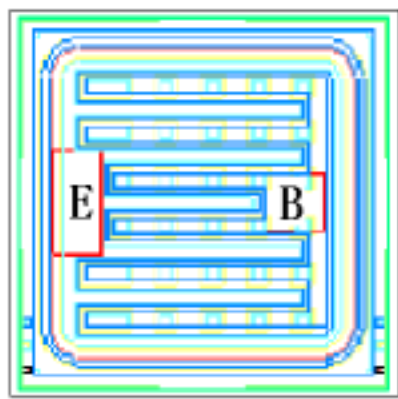


2655 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C080BJ-02
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：800×800μm²
 焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SC2655

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-92L)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极功率耗散 (T_a=25)900mW
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....50V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....50V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....5V
 I_C——集电极电流.....2A
 I_B——基极电流.....0.5A

电参数 (T_a=25) (TO-92L)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	50			V	I _C =100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	50			V	I _C =10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	I _E =100μA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			1	μA	V _{CB} =50V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	μA	V _{EB} =5V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	70		240		V _{CE} =2V, I _C =500 mA
		40				V _{CE} =2V, I _C =1.5A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	I _C =1A, I _B =50mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =1A, I _B =50mA
f _T	特征频率		100		MHz	V _{CE} =2V, I _C =500mA
C _{ob}	共基极输出电容		30		pF	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz